

2012 年 6 月 21 日

新型超级结 MOSFET 的产品规格

所有产品版本共有的项目

- 额定通道温度 (Tch): +150°C
- 额定漏极电压 (VDSS): 600 V
- 额定的栅极源电压(VGSS): ± 30 V
- 额定的漏电流(ID): 20 A at Tc = 25 C
- 导通电阻 (RDS(on)), 典型值: 150 m Ω (当 ID = 10 A, VGS = 10 V 时)
- 反向传输电容 (Crss), 典型值: 13 pF (VDS = 25 V)
- 栅极源阈值电压 (VGS (OFF)): Min. 3 V 至最大 5 V
- 体二极管 FRD 前向电压(VF): 0.96 V (当 IF = 10 A 时)
- 体二极管 FRD 反向恢复时间(trr): 150 ns (当 ID = 20 A 时)

封装

- R JL60S5DPP-E0: TO-220FP
- R JL60S5DPK-M0: TO-3PSG
- R JL60S5DPE-00: LDKAK

(注)

所有其它注册商标或商标为其各自所有者所有。